

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные диоды с барьером Шоттки. Предназначены для использования в гибридных схемах (ГС) с общей герметизацией, а также для сборки дискретных приборов.

Обозначение технических условий

- АДКБ.432120.115 ТУ

Корпусное исполнение

- бескорпусной вариант без кристаллодержателя (подложки) и без выводов

Вид поставки, упаковка

- на общей пластине, неразделенной на кристаллы
- кристаллы в индивидуальной таре

Таблица 1. Основные электрические параметры КДШ2104 при $T_{ср.} = 25 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим и условия измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Значение параметра		
		Мин.	Типовое	Макс.
Постоянный обратный ток диода, ($t_{и} \leq 300 \text{ мкс}$, $Q \geq 100$), мА ($U_{обр} = 40 \text{ В}$) КДШ2104А-5 ($U_{обр} = 60 \text{ В}$) КДШ2104Б-5 ($U_{обр} = 100 \text{ В}$) КДШ2104В-5	$I_{обр}$	-	-	0,5
		-	-	0,5
		-	-	0,5
		-	-	0,5
Постоянное прямое напряжение диода ($I_{пр} = 5 \text{ А}$, $t_{и} \leq 300 \text{ мкс}$, $Q \geq 100$), В КДШ2104А-5 КДШ2104Б-5 КДШ2104В-5	$U_{пр}$	-	-	0,55
		-	-	0,67
		-	-	0,79
		-	-	0,79
Пробивное напряжение диода ($I_{обр} = 10 \text{ мА}$, $t_{и} \leq 300 \text{ мкс}$, $Q \geq 100$), В КДШ2104А-5 КДШ2104Б-5 КДШ2104В-5	$U_{проб}$	40	-	-
		60	-	-
		100	-	-
		100	-	-
Общая емкость диода ($U_{обр} = 5 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$), пФ	C_d	-	-	400

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КДШ2104

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма		
		КДШ2104А-5	КДШ2104Б-5	КДШ2104В-5
Максимально допустимое обратное напряжение диода, В	$U_{обр, max}$	40	60	100
Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение диода ($Q > 2$, $f = 15$ Гц), В	$U_{обр, и, п, max}$	40	60	100
Максимально допустимый средний прямой ток диода ($T_{cp} \leq 25$ °С, $f \geq 15$ Гц, $Q \geq 2$), А *	$I_{пр, ср, max}$	5	5	5
Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток диода ($T_{cp} \leq 25$ °С, $Q \geq 2$, $f \geq 15$ Гц), А *	$I_{пр, и, п, max}$	20	20	20
Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток для единичной синусоидальной полуволны длительностью 5 мс ($T_{cp} \leq 25$ °С), А	$I_{пр, и, нп, max}$	250	250	250
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{пер, max}$	150	150	150
* При сборке в корпус КТ-28-1				



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>